

N₂-COMPATIBLE NICKEL PRECURSOR AND HIGHLY ACTIVE WATER-OXIDATION IRIDIUM CATALYST PREPARED BY MOCVD

トラン, ビエット, ハ

<https://doi.org/10.15017/1543951>

出版情報：九州大学, 2015, 博士（工学）, 課程博士
バージョン：
権利関係：全文ファイル公表済



| | |
|--------|--|
| 氏名 | TRAN VIET HA |
| 論文名 | N ₂ -COMPATIBLE NICKEL PRECURSOR AND HIGHLY ACTIVE WATER-OXIDATION IRIIDIUM CATALYST PREPARED BY MOCVD (窒素雰囲気下で使用可能な MOCVD 用ニッケル前駆体と MOCVD 法により調製される高活性な水酸化イリジウム触媒の開発) |
| 論文調査委員 | 主査 九州大学 教授 氏名 小江 誠司 副査 九州大学 教授 氏名 久枝 良雄 副査 九州大学 教授 氏名 後藤 雅宏 |

論文審査の結果の要旨

本研究は、窒素をキャリアガスに用いる MOCVD によって高純度ニッケル薄膜を初めて作製している。また、MOCVD によってイリジウムとシリコンを含む水の酸化触媒膜の開発に成功している。本研究で得られた知見は、MOCVD による目的に応じた薄膜の作製法だけでなく、触媒開発において有益なものであり、錯体化学と触媒化学上価値ある業績であると認める。